

描述

超小型 RFID 模块 SIMx800，是芯联创展技术团队基于 IMPINJ 新一代射频芯片 E710/E510/E310 研发的高性价比超高频 RFID 读写模块。

输出功率从 5dBm 到 27dBm 可设置，标签读取距离大于 3 米（取决于天线增益和标签尺寸），且具有卓越的多标签盘存性能。

SIMx800 模块功耗低、体积小、稳定可靠，采用先进的多标签识别算法，标签在移动或者静止状态下都能快速识别。

优越的抗干扰设计以及载波抵消功能，在各种环境下都能稳定工作。

多种配置模式，可广泛用于仓储，物流，产线，巡查等各种应用场合。

SIMx800 模块外形尺寸只有硬币大小，邮票半孔封装，仅 1.8 克重，便于嵌入移动便携式设备。



应用

- 手持终端
- 发卡器
- 打印机
- 一体机

特点

- ARMv7-M 架构 32bit Cortex-M4 CPU，集成 FPU、MPU，DSP，最高工作主频 200MHz，512KByte 的 Flash
- 支持 UHF EPC Class1 Gen2/Gen2x
- 提供 Windows，Linux，Android SDK，以及基于 C，C#/.NET，JAVA 的 API
- 支持温度标签盘存，输出参数包含 RSSI，相位值等
- 最大 27dBm 功率输出
- 优异的防冲突算法，高灵敏度，盘存标签最快速度大于 1000tag/s
- 多种盘存模式适应大多数应用
- 可设置 UART 串口通信波特率 9600bps~921600bps
- 两输入两输出 GPIO
- 满功率功耗 3 W
- 表面贴装（SMT），邮票半孔设计，重 1.8 克，尺寸 16.3mm x 16.3mm x 2.6mm

型号	灵敏度 @PER 10%	读标签速度 @96 bit EPC)
SIM7800	-86dbm	>1000
SIM5800	-79dbm	>600
SIM3800	-72dbm	>300

*数据为实验室理想环境测试，仅供参考。

绝对最大额定值

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
输入电压	VCC	-0.3		5.25	V
使能电压	Ven	-0.3		5.25	V
复位(NRST) GPI (IN1 IN2)输入低电压	Vil			0.6	V
复位(NRST) GPI (IN1 IN2)输入高电压	Vih	2.7			V
GPO (OUT1 OUT2)输出电流	Ioh			15	mA
模块输出电流	AVCC			20	mA
天线接口 ESD 保护电压 ¹	Vesd	-1		1	kV
I/O 口 ESD 保护电压 ¹	Vesd	-2		2	kV
天线口 (ANT) 驻波比 ²	VSWR			8	/
工作温度 ³	Tc	-30		75	°C
存储温度	Ts	-55		100	°C



ESD 注意事项

在搬运、包装和测试设备时必须遵守适当的预防措施。

1. 天线端口测试条件 IEC61000-4-2 等级 1，接触放电；其他接口为 HBM 模型，接触放电。
2. 防止功放芯片损坏的最大允许驻波比，为了保证性能，建议天线驻波比小于 1.5。
3. 环境温度，温度最大限值与模块散热条件有关。

通用工作条件

参数	符号	最小值	典型值	最大值	单位
输入电压	VCC	3.6		5.25	V
失能电压	VEN			0.4	V
使能电压		1.5			V
复位(NRST) GPI (IN1 IN2) 输入低电压	VIL			0.3	V
复位(NRST) GPI (IN1 IN2) 输入高电压	VIH		3.3		V
GPO (OUT1 OUT2) 输出电流	IOH		10		mA
GPO (OUT1 OUT2) 输出低电压	VIL			0.3	V
GPO (OUT1 OUT2) 输出高电压	VIH		3.3		V
模块输出电流	AVCC		10		mA
天线口 (ANT) 驻波比 ¹	VSWR			2.5	/
工作湿度 (未冷凝)	RH	5		95	%
工作温度	TC	-20		65	°C
存储温度	TS	-40		85	°C

1. 工作频率范围内, 仅为推荐值。超过此值也可能工作, 不过读标签性能可能会下降。

通用电气参数

参数		条件	最小值	典型值	最大值	单位	
频率	频率范围 ¹		860		960	MHz	
	频率步进值 ²			250/500		KHz	
	频率误差	@25℃	-10		10	ppm	
输出	输出功率		5		27	dBm	
	功率步进			1		dB	
	输出功率精度	5dBm~27dBm	-1		1	dB	
	输出功率平坦度	5dBm~27dBm	-1		1	dB	
	邻道泄露比*	第 1 邻道			-50		dB
		第 2 邻道			-65		dB
	20dB 占用带宽*	RF_MODE 7			125		KHz
		RF_MODE 11			225		KHz
	发射频谱模板* ³	裕量	2			dB	
	杂散发射（传导） ⁴	二次谐波			-60		dBm
三次谐波				-65		dBm	
测量	标签 RSSI 测试精度	@-60dBm	-3		3	dB	
	标签相位测试精度	@-60dBm	-5		5	degrees	
	负载回波损耗测试精度	RL>18dB 接衰减器	-4		4	dB	
UART	默认波特率	数据格式：8N1		115200		bps	
	可设置波特率		9600		921600	bps	
功耗	低功耗模式			0.035		W	
	待机模式			0.75		W	
	工作模式 ⁵	27dBm		3		W	

1. 可同时支持 FCC, CE 频段，其他频率需求请联系技术人员。
 2. 可根据频率区域配置所需频率步进，配置全频段 860-960MHz 时功率精度为±1.5dBm。
 3. 参考《ETSI EN 302 208》4.3.5 Transmitter spectrum masks, 发射盘存信号，盘存模式 RF_MODE 7。
 4. 全频段条件下测试。
 5. 接 50 欧负载，峰值功耗。
- 标注 * 表示测试时采用盘存模式 为 RF_MODE 7, 频谱仪设置 MAXHOLD。

空口模式参数与性能

FCC Mode ID 2 Bytes HEX	ETSI LB Mode ID 2 Bytes HEX	ETSI UB Mode ID 2 Bytes HEX	Old Mode ID 1 Byte HEX	Corresponding Impinj Inventory Mode ID	FCC Mode ID	ETSI LB Mode ID	ETSI UB Mode ID	Old Mode ID	Forward Link Modulation	Tari (µs)	PIE	BLF (kHz)	Reverse Link Modulation	E710 Chip Sensitivity Spec (dBm)	Typical Optimized Read Rate (tags/s)	Supported SKUs
00 67			CB		103			103	DSB-ASK	6.25	1.5	640	FM0	-82.0	1100	E710/E910 E510 E310
00 66		01 2E	6F		102		302	11	PR-ASK	7.5	2	640	FM0	-83.0	950	
00 78			DC		120			120	DSB-ASK	6.25	1.5	640	Miller M=2	-85.0	800	
00 68					104				DSB-ASK	6.25	1.5	320	FM0	-83.0	725	
00 7C		01 43	65	4323 4124	124		323	1	PR-ASK	7.5	2	640	Miller M=2	-85.5	700	
	00 CB						203		PR-ASK	12.5	1.5	426	FM0	-84.0	600	
	00 CA						202		PR-ASK	15	1.5	426	FM0	-85.5	500	
	00 E2						226		PR-ASK	12.5	1.5	426	Miller M=2	-86.5	500	
00 93		01 58	73		147		344	15	PR-ASK	7.5	2	640	Miller M=4	-89.5	450	
00 94		01 59	2D	4345 4148	148		345	345	PR-ASK	7.5	1.5	640	Miller M=4	-90.0	450	
	00 E1						225		PR-ASK	15	2	426	Miller M=2	-88.0	425	
00 7E	00 E0	01 46			126	224	326		PR-ASK	12.5	1.5	320	Miller M=2	-86.5	400	
00 7D	00 DF	01 45	70		125	223	325	12	PR-ASK	15	2	320	Miller M=2	-88.0	350	
00 7B	00 DE	01 44	67	4324/4222 4123	123	222	324	3	PR-ASK	20	2	320	Miller M=2	-88.0	300	
00 BD	01 23	01 82		4189/4291/4386	189	291	386		PR-ASK	10	2	640	Miller M=8	-88.0	280	
00 8D	00 F1	01 56	69	4241/4342 4141	141	241	342	5	PR-ASK	20	2	320	Miller M=4	-90.5	200	
00 92	00 F4	01 57	6B	4244/4343 4146	146	244	343	7	PR-ASK	20	2	250	Miller M=4	-91.0	175	
00 B4	01 19	01 81		4180/4281/4385	180	281	385		PR-ASK	20	2	320	Miller M=8	-92.0	130	
	00 CD						205		PR-ASK	20	2	50	FM0	-77.5	95	
00 B9	01 1D	01 7E	71	4285/4382 4185	185	285	382	13	PR-ASK	20	2	160	Miller M=8	-98.0	70	
Impinj Inventory Mode Special Parameters				4323					Same as above				BPSK M=2	Same as above	Same as above	
				4345									BPSK M=4			
				4222									BPSK M=2			
				4241									BPSK M=4			
				4146									BPSK M=4			
				4285									BPSK M=8			

*固件上未对区域进行 Mode 使用的限制，客户实际应用时需要注意划分。

从上表可以看出来，SIMx800 提供了多种配置方式（不包含混合模式），在读得更好与读得更多之间，需要根据应用需求选择合适的模式。另一项需要注意的是当多阅读器同时工作时，会存在干扰。更小的 TARI 虽然加快了与标签的通信连接，但会增加发射信道的带宽，更容易干扰其他读写器。更高的标签的反向散射链路频率 (BLF) 提高了标签反向传输信号的速度，标签返回信号会落在相邻信道内，当有其他读写器正好工作在这个信道内时，读写器很可能无法解调出标签的返回信号。

盘存模式参数

针对不同的应用场景，SIMx800 提供了多种工作模式。除了控温多标签盘存模式，其他都由读写器模块自动完成，不仅节省了主机与读写器模块的命令交互时间，优秀的处理算法也大大增强了产品的应用适配性。

应用场景	工作模式	推荐配置
少量标签 远距离	普通	读时长 100~800ms，读间隔 0ms。 RF_MODE 13, Session0, Target A, Q 自动。
	快速/ 多标签快速	RF_MODE 13, Session0, Target A, Q 自动。
少量标签 多次重复	快速/ 多标签快速	RF_MODE:E710=103, E510=120, E310=12(查表)。 Session1, Target A-B。 可选:静态 Q(例如四张标签 Q=3/4)，定频。
大量标签读全 (无需认证)	EX10 快速/ E7 新快速	RF_MODE/Session/Target/Q 模块自动调整(配置无效) 可选:全频段，波特率 921600，功率 3300，注意散热。
大量标签读全 (过认证版本)	快速/ 多标签快速	手动尝试切换 RF_MODE 11/7/13, Session2, 手动 Q。 可选:全频段，波特率 921600，功率 3300，注意散热。
控温/低功耗 多标签盘存	E7 智能(控 温)	RF_MODE 自动调整,当新增标签少时，自动减少占空比，当 新增标签多时，恢复全速读取。 用于长时间续航测试/低功耗测试。
极大量标签 前几秒尽量多读	快速/ 多标签快速	RF_MODE:E710=103, E510=120, E310=12(查表)。 Session2/3, Target A, 静态 Q(例如 1 万张标签 Q=14)。

※上述部分模式不支持海外版本，在主板以及通讯接口支持的前提下，将波特率提升至 921600bps 效果更好（默认波特率 115200bps），具体请咨询我司技术人员。

引脚配置及功能

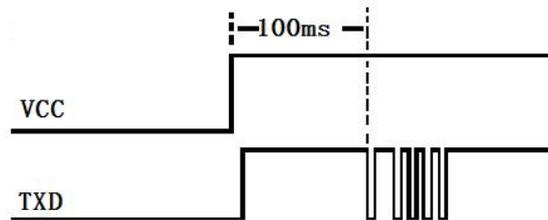


引脚	定义	描述
1	VCC	供电电压，3.6V~5V 输入
2	GND	地
3	EN	内置上拉 100k 电阻至 VCC。 接高 (1.5~VCC) 或悬空时，模块正常工作。 接低 (-0.3~0.3V) 时，模块断电。
4	OUT2	GPO，推挽输出，默认逻辑 0 低，逻辑 1 高
5	IN1	GPI，内置上拉 30k 电阻，默认逻辑 1 高 高电平 (2.7~3.3V)，低电平 (-0.3~0.3V)
6	IN2	GPI，内置上拉 30k 电阻，默认逻辑 1 高 高电平 (2.7~3.3V)，低电平 (-0.3~0.3V)
7	RXD	模块 UART 输入，适配 3.3V TTL 电平
8	TXD	模块 UART 输出，适配 3.3V TTL 电平
9	NRST	内置上拉 10k 电阻。 接高 (2.7~3.3V) 或悬空时，模块正常工作。 接低 (-0.3~0.3V) 时，模块复位。
10	OUT1	GPO，推挽输出，默认逻辑 0 低，逻辑 1 高
11	GND	地
12	AVCC	3.3V 输出，建议驱动电流不大于 20mA
13	SWCLK	SWD 烧录接口，时钟线，悬空
14	SWDIO	SWD 烧录接口，数据传输线，悬空
15	NC	悬空，不可接地
16	NC	悬空，不可接地
17	GND	地
18	GND	地
19	ANT	接天线
20	GND	地

应用说明

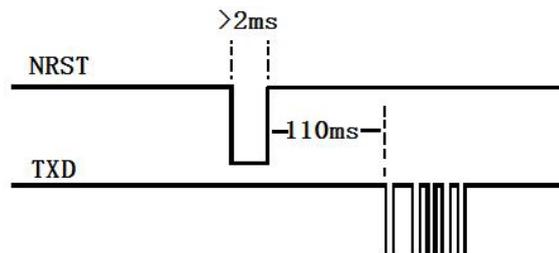
● 上电启动与 I/O 接口

模块从上电运行到应用层程序，需要花费 100ms 进行初始化，在这段时间内不要拉低复位引脚，读写器模块也不会响应接收到的命令。



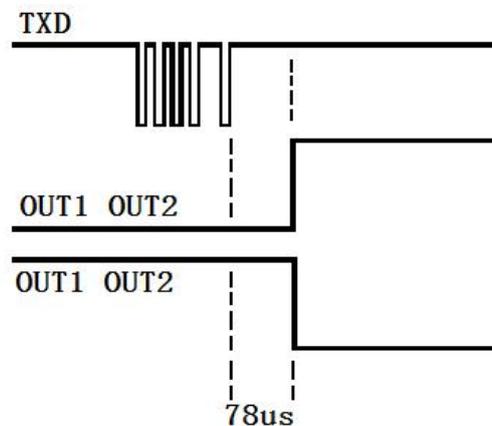
上电启动时间

NRST 上电复位解除时间小于 3ms，模块上电后，NRST 电平拉低会使内部模块的 MCU 重新启动。模块内 NRST 已接 100K 上拉电阻。如果模块已上电，触发复位的低电平保持时间需大于 2ms。当复位发生时，等待复位时间需大于 110ms。

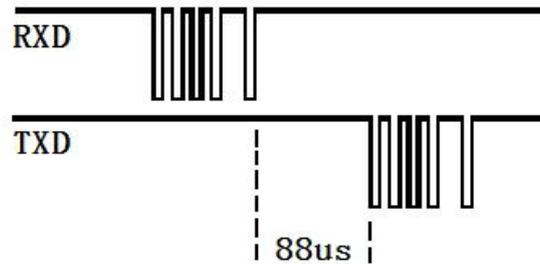


复位等待时间

OUT1, OUT2 设置命令动作时间大于 78us (不含命令时间)。IN1, IN2 设置命令动作时间大于 88us (不含命令时间)。



OUT1, OUT2 动作时间



IN1, IN2 动作时间

EN 高电平使能上电，内部已经上拉 100K 电阻。

● 输入电源

VCC 端口建议使用一个 22~100uF 的钽电容, 如果尺寸限制, 也可以改为小尺寸的陶瓷电容, 并且至少并联一个 0.1uF 与一个 100pF 陶瓷电容。模块工作时的最大电流将近 0.6A (当天线端口失配)。在盘存标签时, 会快速开启和关闭发射信号, 导致模块输入端电源也随着产生电压波动。大容量电容可以减小纹波幅度, 除了滤除低频信号的干扰, 却也引起瞬间电流过大, 根据供电电路的驱动能力, 选择合适容量退耦电容。0.1uF 和 100pF 电容用于滤除高频段的电源纹波, 因为高频段的干扰信号, 特别是工作频段内的干扰信号进入到模块会使模块的读标签性能下降, 此外陶瓷电容的加入也能防止模块工作时产生的高频信号通过电源通路, 干扰到其他电路系统。

由于模块工作电流大, 连接模块 VCC 端口的走线要足够粗, 否则连接线两端会产生过大的压差, 当模块输入端电压低于 3.3V, 将使模块无法正常工作; 过细的连接线也更容易辐射出干扰信号。

如果输入的电源电压比较低, 或者电源电压非稳定的(比如用电池给模块供电), 建议先采用升/降压电路将电压钳位到一个固定电压(比如 5V), 这样能保证模块性能的一致性。如果升压/降压电路是 DC-DC 转换电路, 优先选择开关频率超过 1.5MHz 的电源转换芯片, 相比开关频率低的电源芯片可能转换效率低一点点(一般 5%以内), 但避免对标签返回的微弱信号产生干扰。

● 通讯串口

读写器模块可采用 3.3V UART 串口进行数据通信，数据格式配置为 1 位起始位，8 位数据，1 位停止位，无校验位（8N1）。

串口进行通信时，串口通信信号产生的频率与杂散和标签返回的 BLF 信号接近，有可能会通过传导与辐射的方式进入到模块射频芯片的接收端。由于标签散射回模块的信号很弱，当这样的干扰发生时，会使模块的接收性能急剧下降。

如果串口的 PCB 走线较长，可将走线布在 PCB 的内层或者布在放置天线相反的 PCB 层上，同时预留用于串联的匹配电阻和到地的并联电容，这可以用于减小串口信号的振铃；当需要采用板间连接线连接时，连接线最好贴地布线。

● 天线端口

当模块与天线不匹配时，从天线反射回读写器模块的功率过大，这会使接收灵敏度恶化，特别是使用 E710 芯片的模块灵敏度影响程度更大。举例说明，采用 RF_MODE 7 进行测试，满功率工作，与匹配较好的情况相比，在驻波比为 2.0（回波损耗约-9.5dB）时，使用 E710 芯片的模块灵敏度恶化约 4dB~5dB，使用 E510 芯片的模块恶化约 1dB~2dB，使用 E310 芯片的模块恶化程度在 1dB 以内。因此，当使用 E710 芯片的模块应用在需要快速读取大量标签的应用场合时，如果天线驻波较大，会极大地增加读全标签的时间；对于距离近标签少的应用环境，选择使用 E510 或者 E310 的模块更加合适。

由于模块内的功放芯片与天线之间并未使用 RF 隔离器或者 RF 环形器进行隔离，当功放芯片与天线不匹配时，功放芯片输出的线性度与转换效率会发生变化。前者会使发射性能发生变化，比如功率输出减小，辐射杂散与频谱模板不符合当地无线电法规要求等等；后者则会使模块的功耗增加，增加了工作温度，从而使使用寿命减小。当功放芯片工作在不稳定区域时产生自激，这种情况下功放芯片则容易损坏。虽然 SIMx800 采用了对失配容忍度很高的功放芯片，并且在最差的情况下（模块天线端开路，VSWR=+∞）进行了长时间的测试（超过一周）也未发生损坏，但是并不能覆盖所有的匹配情况。如果有测试条件，在产品整体测试时可检查其与接 50 欧负载相比的功耗情况，功耗增加量不要超过 0.75W（具体视模块的散热情况而定，当散热良好时，限制条件可以放宽，此处仅作为模块使用时失配程度的直观判断，并不一定准确）；为

保证模块的盘存性能，并能长期稳定工作，建议将天线安装在应用环境中后，检测一下连接天线后的驻波比，天线驻波比尽量小于 1.5 (回波损耗约-14dB)。如果输出功率较低，可以降低驻波比的要求。

● 静电保护

SIMx800 天线接口的 ESD 测试只能达到 $\pm 1\text{KV}$ ，如果需要满足更高的要求，就要增加 ESD 保护电路。

当过强的静电进入到天线端口，会损坏功放芯片与读写器芯片。有一种情况是，模块还能工作，但性能已经发生了改变。从天线端口静电测试情况来看，大多数表现在标签的接收灵敏度变差约 7dB，也有可能情况更加严重，所以产品整体测试时需要关注这一项的性能是否发生了变化。简单的测试方法是与一个工作正常的产品作对比，比如定频读取同一个标签（先确保 RSSI 值不小于-60），对比两者的 RSSI 值，一般 RSSI 的变化应小于 $\pm 3\text{dB}$ 。

参考电路中给出了一种 ESD 保护电路(天线端口采用电感电容组成的高通滤波电路)，在模块未上电的情况下测试，天线端口在 $\pm 8\text{KV}$ 未发生损坏，但电路会增加约 0.3dB 左右的插入损耗，模块与天线或者负载的匹配也发生了改变。另一种 ESD 保护的方法，是直接增加低寄生电容的双向 ESD 保护二极管，相比于上面的方法，插入损耗会更低，匹配的改变程度也更小，不过要注意，ESD 保护二极管的使用，有可能使发射的射频波形产生失真，从频谱仪上可以观测到高次谐波分量有增加（一般 2、3 次谐波增加得更多）。为了满足当地无线电法规要求，请选择合适的 ESD 保护二极管。

在实际应用中，如果所使用天线的辐射面与地能充分连接，也能对天线端口起到部分的 ESD 保护作用。

● 屏蔽说明

SIMx800 使用金属屏蔽盖作电磁屏蔽，如前面描述的，邮票孔封装的模块需要通过一段微带线与不同的天线或者负载相连接，这会减弱金属屏蔽盖的作用，并且由于匹配发生了变化，功放芯片输出的射频参数也会跟着变化，这都有可能使产品的辐射杂散指标超过要求门限值。

当产品的辐射要求比较严格时，建议在 SIMx800 模块周边额外再增加一层屏蔽，这会减小辐射杂散超标的风险。

● 散热说明

SIMx800 尺寸较小，很难通过模块本身将工作时产生的热量发散出去，所以模块提供了尽量多的散热焊盘（见封装信息）。

SIMx800 贴在底板上时，底板需要考虑散热，保证模块的工作温度不要过高。当标签不多，或者不需要实时盘存时，可以根据模块温度调节模块的工作间隔。如果觉得这个方法占用了盘存标签的时间，可以使用模块提供的控温多标签盘存模式。

在 SIMx800 模块中，功放芯片是主要的发热芯片，所以主要考虑它的温度要求，可通过下面的公式大概计算功放芯片结温：

输出功率 P_{out} ；模块整体功耗 P_{mod} ；EX10 芯片功耗与 CPU 等外围电路功耗为 P_{ext} ；功放的耗散功率：

$$P_{diss} = P_{mod} - P_{out} - P_{ext}$$

在这里假设功放热阻系数：

$$R_{th_PA} = 30^{\circ}\text{C}/\text{W}$$

模块系数热阻： R_{th_BOARD} （与底板和散热设计有关，更好的散热，热阻会降低）

模块上的功放芯片热阻系数：

$$R_{th} = R_{th_PA} + R_{th_BOARD}$$

PA 结温 (Junction Temperature@55°C ambient)

$$T_J = 55^{\circ}\text{C} + P_{diss} \times R_{th} < 135^{\circ}\text{C}$$

135°C 的 PA 结温限值小于功放芯片所允许的最大结温 150°C，这是为了保证模块工作稳定，降低了温度限值。

从上面的公式可知，如果要使模块可正常工作的最大环境温度增加，需要减小模块的热阻系数 R_{th_BOARD} 。

有时不能准确获得 R_{th_BOARD} 的值，因为它和产品（使用了 SIMx800 模块）的散热方式有关。为此，可以通过测试的方式大概估计 R_{th_BOARD} 的值。为了进一步说明，做了下面的测试。

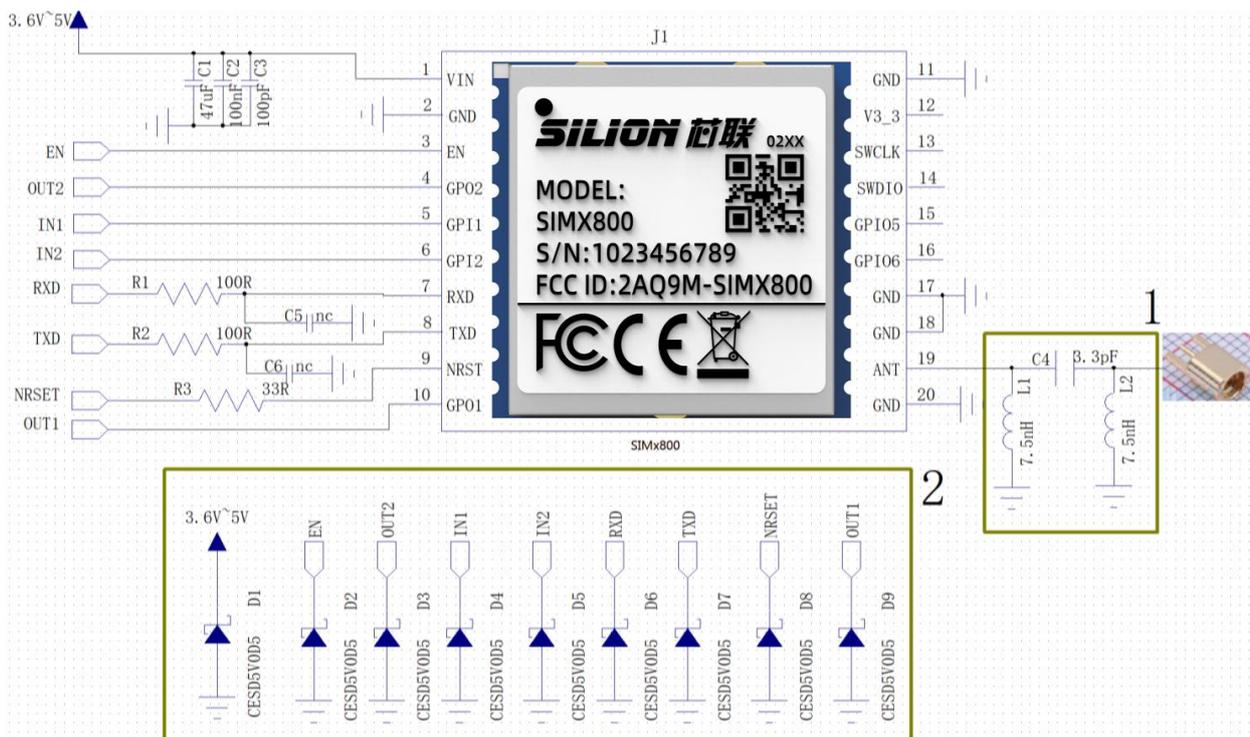
将 SIM7600 模块贴在一块长 29mm，宽 29mm，厚 1.0mm，板材为 FR4 的底板上，SIM7600 底部涂满导热硅脂 (Kafuter K-5211H)，测量环境温度 $T_{ambient}=28^{\circ}\text{C}$ ， $P_{out}=31.6\text{mW}$ (15dBm)， $P_{mod}=1.65\text{W}$ ， $P_{ext}=1\text{W}$ ，测量得到功放芯片表面温度 81°C ，读写器芯片 E710 表面温度 70°C ，模块其他区域最大温度 67°C ，底板温度 70°C 。假设功放芯片结温与芯片表面温度差 10°C (这个

数值有可能更小)，计算得到（仅用于大概评估，非精确结果，实际是输出功率越高，计算结果越准确）：

$$R_{th_BOARD} = (81^{\circ}\text{C} + 10^{\circ}\text{C} - 28^{\circ}\text{C}) / (1.65\text{W} - 1\text{W} - 0.0316\text{W}) - 30^{\circ}\text{C}/\text{W} = 71.8^{\circ}\text{C}/\text{W}$$

显然底板的散热能力不够导致 R_{th_BOARD} 过高，需要使用更好的散热方式。

● 参考电路



1. 增加了 ESD 保护能力，会引入额外的插入损耗，天线端口匹配也发生改变。如果 ESD 满足要求，尽量不增加此电路。

2. 根据实际需要选择合适的 ESD 保护二极管。如果 SIMx800 通信及电源接口不与产品外部接头相连接，ESD 保护二极管一般可以省略。

3. 为了在更低的供电电压下工作，单片机供电电压采用了 3.3V，建议在接口上预留串接电阻。

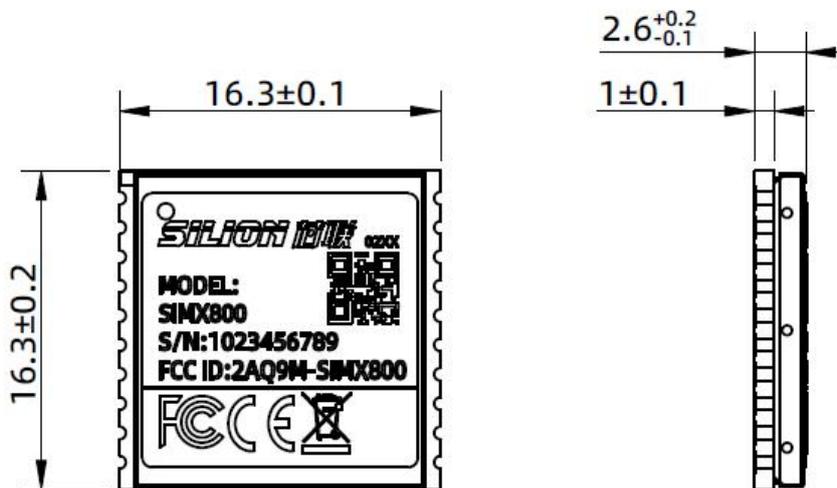
● 标记说明

Pin 1 标识	●		02 表示 V2.0 硬件版本， xx 根据出厂初始化区域变动
模块型号：	MODEL:		SN 二维码
SIM7800	SIM3800		
SIM5800	S/N: 1025130546		SN 码：
SIM3800	FCC ID:2AQ9M-SIM3800		XX:工厂代码
相关认证标识区			YYXX:年份+周数
			XXXX:16 进制流水号

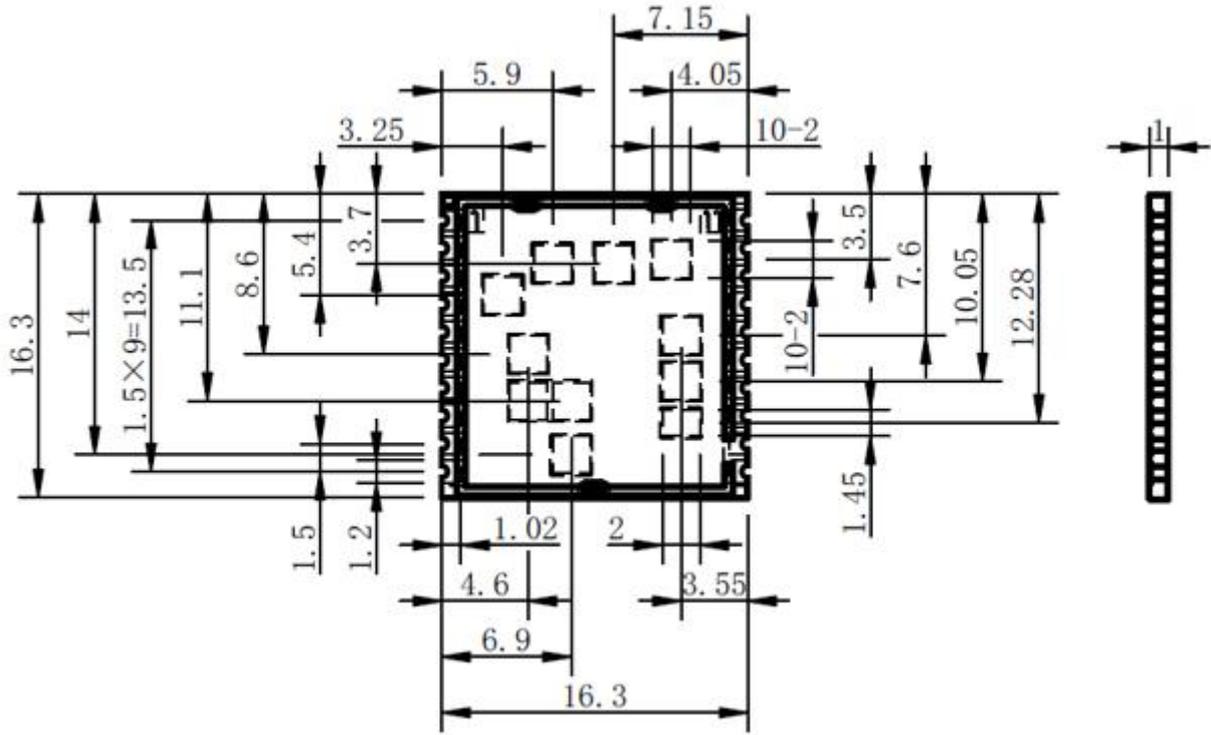
尺寸与封装信息

● 封装尺寸

16.3mm x 16.3mm x 2.6mm (长 x 宽 x 高), 重 1.8g

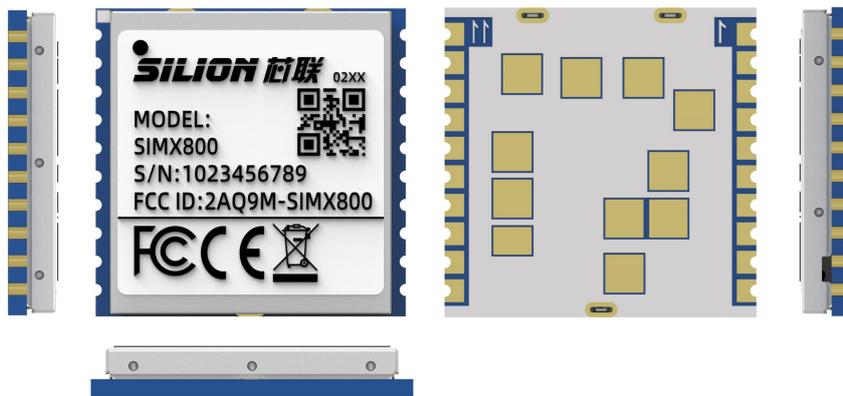


● PCB 焊盘

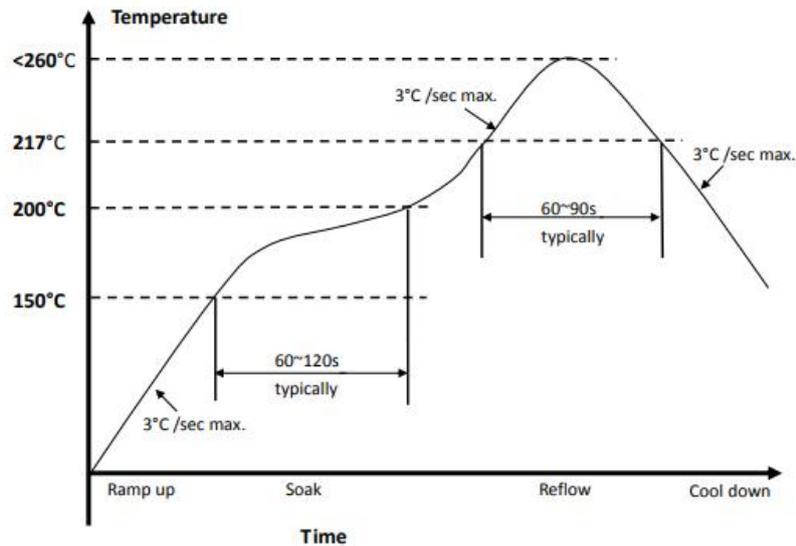


圆形焊盘内孔是射频走线过孔，模块所贴底板这个位置不铺铜，底板的下一层要铺地。建议使用提供的模块封装，减小电路设计的时间。

● 外观示意图



SMT 回流焊信息



贴片回流焊推荐使用上图的温度控制

1. 参照 IPC/JEDEC 标准。
2. 峰值温度： <math><260^{\circ}\text{C}</math>。
3. 回流焊循环次数： 最大 2 次。
4. 在回流焊过程中加入氮气 (N_2) 以实现 2000ppm 或更低的氧气浓度要求。
5. 烘烤温度要求为 $125^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$ ，烘烤时间要求：
 - A. 对于在三个月以上六个月以内烘烤时间为 4H。
 - B. 对于在六个月以上烘烤时间为 24H。

订购信息

型号	PART NUMBER	发射功率	支持频段	描述
SIM7800	10. 78000000. 04	27dBm	860MHz~960MHz	FCC&CE&OPEN
	12. 78000000. 04	27dBm	860MHz~960MHz	SRRC&OPEN
SIM5800	10. 58000000. 04	27dBm	860MHz~960MHz	FCC&CE&OPEN
	12. 58000000. 04	27dBm	860MHz~960MHz	SRRC&OPEN
SIM3800	10. 38000000. 04	27dBm	860MHz~960MHz	FCC&CE&OPEN
	12. 38000000. 04	27dBm	860MHz~960MHz	SRRC&OPEN

※默认为初始化 CHINA 区域，北美频段 902MHz~928 MHz，用户可以指定出厂频段，订购前请与销售联系确认产品参数，非特殊要求，模块默认发货使用最新软硬件版本。

版本信息

文档编码: SL-RD-QR-23070606		
版本	日期	修订内容
V1.0	2023/7/06	首版编辑
V1.1	2025/9/17	①修改可同时支持 FCC, CE 频段 ②复位(NRST), GPO(OUT1 OUT2) 输出高电压, AVCC 输出电压修改为 3.3V ③修改低功耗模式与待机模式电流
.....		

联系方式

如果您有产品需求或者在产品使用中有任何疑问，请随时与我们联系，我们将竭诚为您服务。

北京公司总部

地 址：北京市昌平区龙域北街 3 号金域国际中心 A 座 5 层

电 话：010-62153840，62153842，62153540

传 真：010-62153540 转 8008

网 址：www.silion.com.cn

电子邮件：sales@silion.com.cn

芯联创展华南区分公司

地 址：深圳市南山区珠光路 52 号珠光创新科技园 1 栋 3 层

电 话：0755-26611567

传 真：0755-26617878

芯联创展华东区办事处

地 址：上海市嘉定区云谷路 599 弄 6 号楼 TEEC 上海中心大厦 311 室

电 话：15901906309

联 系 人：范经理